

« КРЕМНИЙ-2008 »

V Международная конференция и IV школа молодых ученых и специалистов по актуальным проблемам физики, материаловедения, технологии и диагностики кремния, нанометровых структур и приборов на его основе
Черноголовка, 1–4 июля 2008

Организаторы конференции:

- Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН
- Государственный технологический университет «Московский институт стали и сплавов»
- Научный Совет РАН «Физико-химические основы материаловедения полупроводников»
- При участии ООО «Научно-консалтинговый центр Форум-СМ»

«КРЕМНИЙ-2008» является продолжением серии конференций, последняя из которых состоялась в МИСиС в 2007 году. Это форум, где ученые, представляющие академическое сообщество, ВУЗы и промышленность России, стран СНГ и дальнего зарубежья, могут обсудить актуальные проблемы по всему кругу вопросов, включающему рост и материаловедение объемных кристаллов и тонких пленок кремния и родственных материалов, а также физику, технологию и диагностику наноструктур на их основе. В рамках Школы для молодых ученых и специалистов признанными экспертами будут прочитаны лекции по наиболее важным проблемам современной микро- и наноэлектроники. На конференции будут представлены приглашенные доклады ведущих ученых, работающих в области материаловедения кремния и его применений, а также устные и стендовые доклады, отобранные Оргкомитетом из числа присланных тезисов. Предварительный список лекций и приглашенных докладов представлен на сайте Конференции.

Официальные языки конференции русский и английский.

Тезисы

Со 2 февраля по 3 марта 2008 г. объявляется прием тезисов докладов на конференцию «КРЕМНИЙ-2008». Тезисы объемом 1 (одна) страница направляются в оргкомитет по электронной почте на адрес silicon2008@iptm.ru (Subject:Abstract) в виде одного или нескольких прикрепленных файлов в формате MS_Word.DOC (одни тезисы в каждом файле). Тезисы принимаются только в электронном виде. Более подробная инструкция по оформлению тезисов содержится в шаблоне, который доступен для скачивания на сайте конференции (<http://purple.iptm.ru/silicon2008>), а также может быть выслан по электронной почте по запросу (silicon2008@iptm.ru). Предполагаемый докладчик должен (если не сделал этого ранее) заполнить форму предварительной регистрации.

Оргкомитет не гарантирует рассмотрение тезисов, поступивших после 3 марта 2008 г. Авторы тезисов будут проинформированы о включении докладов в программу конференции в начале апреля. Тезисы принятых докладов будут опубликованы к началу мероприятия в сборнике тезисов, который будет выдаваться участникам, оплатившим оргвзнос.

Предварительный список приглашенных докладов на конференции

- | | |
|---|--|
| Абросимов Н.В.
IKZ (Берлин)/ИФТТ РАН | “Выращивание объемных кристаллов твердого раствора SiGe” |
| Балыкин В.И.
ИС РАН (Троицк) | “Новый способ создания атомно-молекулярных наноструктур на поверхности методами атомной оптики” |
| Барабаненков М.Ю.
ИПТМ РАН (Черноголовка) | “Резонансные оптические эффекты и новые оптические материалы кремниевой микрофотоники” |
| Бородин В.А.
ЭЗАН (Черноголовка) | “Развитие оборудования для выращивания кристаллов из расплава” |
| Герасименко Н.Н.
МИЭТ (Зеленоград) | “Радиационное формирование наноструктур в объемном монокристаллическом кремнии” |
| Грибов Б.Г.
Завод "Микрон"(Зеленоград) | “Новые технологии получения кремния” |
| Двуреченский А.В.
ИФП СО РАН (Новосибирск) | “Физические явления и технологии в основе кремниевых наноструктур с квантовыми точками” |
| Земсков В.С.
ИМЕТ РАН (Москва) | “Развитие представлений о факторах, приводящих к возникновению полосчатой примесной микронеоднородности в монокристаллах кремния, выращиваемых методом Чохральского” |
| Кведер В.В.
ИФТТ РАН (Черноголовка) | “Геттерирование примесей и инженерия дефектов в кремнии для солнечной энергетики” |
| Конончук О.В.
"SOITEC"(Гренобль) | “Latest trends in SOI technology: Direct Silicon Bonding” |
| Красников Г.Я.
Завод "Микрон"(Зеленоград) | “Состояние и перспективы развития микроэлектроники в России” |
| Литовченко В.Г.
ИФП НАНУ (Киев) | “Исследование процесса распада кремний-оксидных композитов при формировании Si-нанокластеров” |
| Мордкович В.Н.
ИПТМ РАН (Черноголовка) | “Датчики на основе структур Кремний-На-Изоляторе” |
| Новиков А.В.
ИФМ РАН (Н. Новгород) | “Люминесценция и фотопроводимость в области длин волн 1.3-1.55 мкм в SiGe гетероструктурах с самоформирующимися nanoостровками” |
| Пархоменко Ю.Н.
ГИРЕДМЕТ (Москва) | “Состояние и проблемы развития производства поликристаллического кремния в России и странах ближнего зарубежья” |
| Полисан А.А.
МИСиС (Москва) | “Состояние и проблемы развития производства солнечных батарей” |
| Сауров А.Н.
МИЭТ (Зеленоград) | “Методы самоформирования в технологии микро- и наноэлектроники” |
| Соболев Н.А.
ФТИ им. А.Ф. Иоффе
(Санкт-Петербург) | “Светодиоды на основе кремния” |
| Суэтин Н.
"ИНТЕЛ А/О"(Москва) | “Современное состояние и проблемы кремниевых нанотехнологий” |
| Тетельбаум Д.И.
НИФТИ (Н. Новгород) | “Нановключения элементов IV группы в оксидных диэлектриках” |
| Ярыкин Н.А.
ИПТМ РАН (Черноголовка) | “Свойства димеров кислорода в кремнии” |

Предварительный список лекций на школе

Алексеев С.В. НПО "Луч" (Подольск)	"Радиационная стойкость полупроводниковых материалов"
Бердников В.С. ИТФ СО РАН (Новосибирск)	"Влияние параметров процесса выращивания монокристаллов кремния на гидродинамические процессы в расплаве"
Бублик В.Т. МИСиС (Москва)	"Высокоразрешающая рентгеновская дифрактометрия при исследовании микродефектов в кремнии"
Вяткин А.Ф. ИПТМ РАН (Черноголовка)	"Макропористый кремний – технологии получения и актуальные применения"
Герасименко Н.Н. МИЭТ (Зеленоград)	"Радиационная стойкость наноструктур"
Дашевский М.Я. МИСиС (Москва)	"Материаловедение кремния (состояние и некоторые проблемы)"
Ежлов В.С. МИСиС (Москва)	"Современные установки для выращивания монокристаллов кремния и сапфира (состояние разработок)"
Зайцев С.И. ИПТМ РАН (Черноголовка)	"Новые методы наноструктурирования для планарных нанотехнологий"
Казанский А.Г. МГУ (Москва)	"Аморфный и нанокристаллический кремний: Методы получения и основные физические свойства"
Кобелева С.П. МИСиС (Москва)	"Сопротивление растекания – динамично развивающийся метод прецизионного контроля распределения электрически активной примеси в субмикронных и нанометровых полупроводниковых структурах"
Мильвидский М.Г. ИХПМ (Москва)	"Актуальные проблемы материаловедения кремния"
Осипов Ю.В. МИСиС (Москва)	"Влияние электрического поля на процессы диффузии в полупроводниках (в том числе в кремнии)"
Пчеляков О.П. ИФП СО РАН (Новосибирск)	"Эпитаксия GaAs на кремниевых подложках: Современное состояние исследований и разработок"
Смирнов В.К. "Wostec" (Ярославль)	"Волнообразные наноструктуры на поверхности кремния, инициируемые ионной бомбардировкой"
Шульпина И.Л. ФТИ им. А.Ф. Иоффе (Санкт-Петербург)	"Высокоразрешающая рентгеновская топография при исследовании дефектов в кремнии"

Оргвзнос

Оргвзнос за участие в Школе и Конференции составляет 1500 рублей и включает участие в технических сессиях, экземпляр сборника тезисов и кофе в перерывах.

Студенты и аспиранты регистрируются на Школе и Конференции бесплатно. Студенческая регистрация не включает сборника тезисов. Все желающие могут приобрести дополнительный экземпляр сборника тезисов по себестоимости.

Проживание

Для иногородних участников конференции возможно проживание в гостинице г. Черноголовка. С условиями проживания и расценками можно ознакомиться на сайте гостиницы <http://www.hotel.chg.ru>

Следите за обновлениями на сайте <http://purple.ipm.ru/silicon2008>